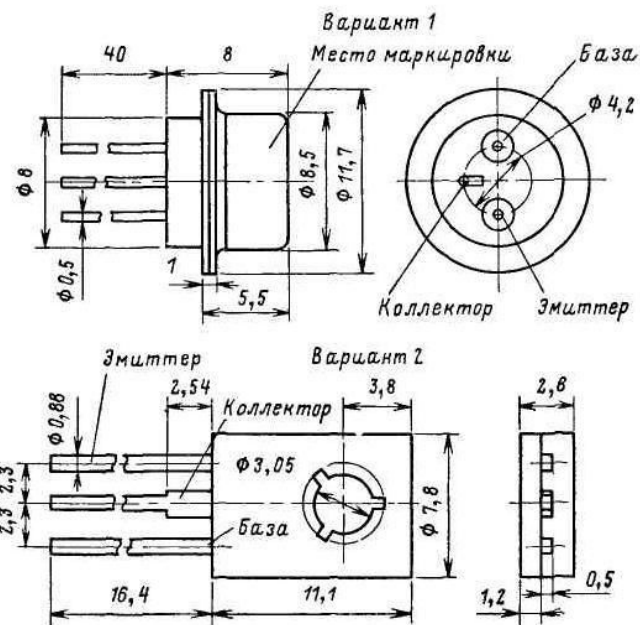


КТ605А, КТ605Б, КТ605АМ, КТ605БМ

Транзисторы кремниевые меза-планарные *n-p-n* универсальные высокочастотные маломощные.

Предназначены для применения в импульсных, переключаемых и усилительных высокочастотных схемах.



Выпускаются в металлостеклянном (КТ605А, КТ605Б – вариант 1) и пластмассовом корпусах с гибкими выводами (КТ605АМ, КТ605БМ – вариант 2). Обозначение типа приводится на корпусе. Масса транзистора в металлостеклянном корпусе не более 2 г, в пластмассовом не более 1 г.

Электрические параметры

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 20$ мА, $I_B = 2$ мА не более	8 В
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $I_3 = 20$ мА, $U_{КЭ} = 40$ В	
КТ605А	10 – 40
КТ605Б	30 – 120
Граничная частота коэффициента передачи тока при $U_{КЭ} = 40$ В, $I_3 = 20$ мА не менее	40 МГц
Емкость коллекторного перехода при $U_{КЭ} = 40$ В, $f = 2$ МГц не более	7 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 0$ В, $f = 2$ МГц не более	50 пФ
Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{КЭ} = 250$ В не более	20 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ} = 5$ В не более	50 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база	
при $T \leq 373$ К	300 В
при $T = 423$ К	150 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} \leq 1$ кОм	
при $T \leq 373$ К	250 В
при $T = 423$ К	125 В
Постоянное напряжение эмиттер-база	
при $T \leq 373$ К	5 В
при $T = 423$ К	2,5 В
Постоянный ток коллектора	100 мА
Импульсный ток коллектора	200 мА
Постоянная рассеиваемая мощность	
при $T \leq 298$ К	0,4 Вт
при $T = 373$ К	0,17 Вт
Температура перехода	423 К
Тепловое сопротивление переход-среда	300 К/Вт
Температура окружающей среды	От 233 до 423 К

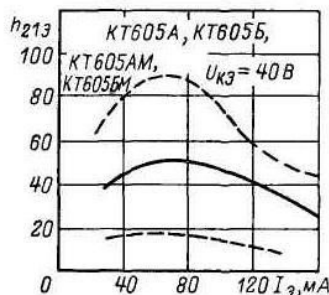
Примечание Пайку выводов допускается производить на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора не более 5 с. Температура пайки не должна превышать 533 К.

При пайке должен быть обеспечен надежный теплоотвод между местом пайки и корпусом транзистора.

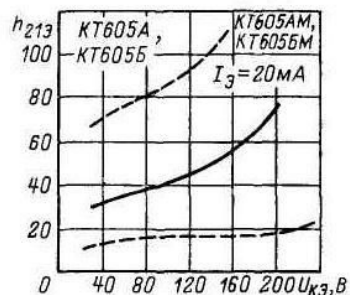
Для транзисторов в пластмассовом корпусе изгиб выводов допускается под углом не более 90° в плоскости, перпендикулярной плоскости основания корпуса, и на расстоянии не менее 3 мм от корпуса с радиусом изгиба не менее 1,5 мм.

При установке транзистора на печатную плату с шагом координатной сетки 2,5 мм допускается односторонняя формовка выводов с их разводкой для совмещения с монтажными отверстиями (контактами).

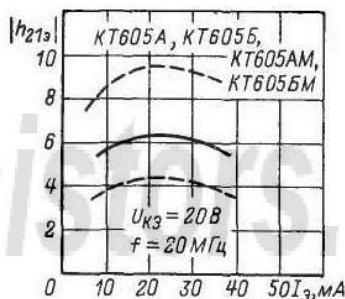
При изгибе и формовке выводов необходимо применять специальные шаблоны, а также обеспечивать неподвижность выводов между местом изгиба и корпусом транзистора. Кручение выводов вокруг оси не допускается.



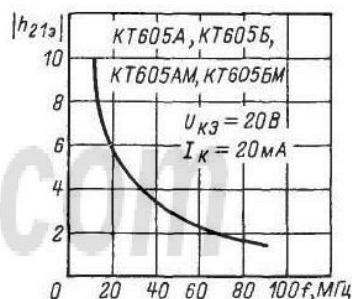
Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



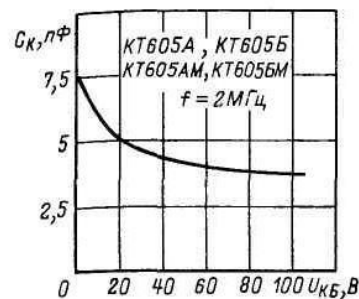
Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от напряжения коллектор-эмиттер



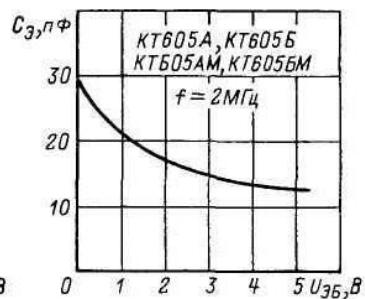
Зона возможных положений зависимости модуля коэффициента передачи тока от тока эмиттера



Зависимость модуля коэффициента передачи тока от частоты



Зависимость емкости коллекторного перехода от напряжения коллектор-база.



Зависимость емкости эмиттерного перехода от напряжения эмиттер-база.